

電界効果トランジスタ

2SK155

2SK155

T-29-25

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

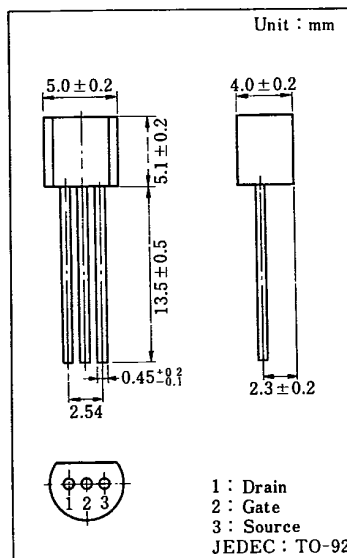
低周波低雑音増幅用 / AF Low-Noise Amplifier

■ 特徴 / Features

- 相互コンダクタンス g_m が高い。 / High g_m
- 入力換算雑音電圧 e_n が小さい。 / Small e_n

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	20	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSO}	20	V
ドレイン電流	I_D	30	mA
許容損失	P_D	400	mW
接合部温度	T_J	125	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0$	0.5	5	30	mA
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0$			100	nA
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=10\text{ }\mu\text{A}$	0.1		1.5	V
相互コンダクタンス	g_{m1}	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=0.5\text{ mA}, f=1\text{ kHz}$	3			mS
	g_{m2}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, f=1\text{ kHz}$	8	45		mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{ V}, -V_{GS}=3\text{ V}, f=1\text{ MHz}$		40		pF
出力容量	C_{oss}			18		pF
帰還容量	C_{rss}			17		pF
入力等価雑音電圧	e_{n1}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, R_g=0, f=10\text{ Hz}$		1.1		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	e_{n2}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, R_g=0, f=1\text{ kHz}$		0.7		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$

* I_{DSS} ランク分類 / I_{DSS} Classifications

Class	P	Q	R	S	T
I_{DSS} (mA)	0.5~4	2~6	4~12	10~20	18~30

電界効果トランジスタ

2SK155

T-29-25

